

硅片采购规范

Characteristics	Specification
Growth Method 晶体生长方法	CZ
Type/Dopant 型号/掺杂	P/Boron
Orientation (degree) 晶向	{100}±0.5
Diameter (mm) 直径	150±0.2
Resistivity(ohm.cm) 电阻率	1-30
Primary Flat Length (mm) 主参考面长度	Notch
Primary Flat Orientation (degree) 主参考面位置	{110}±1
Oxygen Contents (at/cm ³) 氧含量	≤1.8×10 ¹⁸
Carbon Contents (at/cm ³) 碳含量	≤0.5×10 ¹⁷
Thickness (μm) 厚度	675±25
TTV (μm) 总厚度变化	≤10
WARP (μm) 翘曲度	≤30
Particles (ea/wafer) 表面颗粒	<20 (> 0.3μm)
Backside Laser Mark 背面刻号	N
Polished Side Laser Mark 正面刻号	N
BSD	N
POLY(A) 多晶 Si 厚度	N
Oxide Backseal (Å) 背封 SiO2 厚度	N
Edge Oxide Strip (mm) 边缘氧化膜去除	N
Edge Round Angle 倒角	Semi Std
Edge Polished 边缘抛光	N